

IMB4

アイソレーテッドミニモールドデバイス インバータドライバ/Inverter Driver Isolated Mini-Mold Device

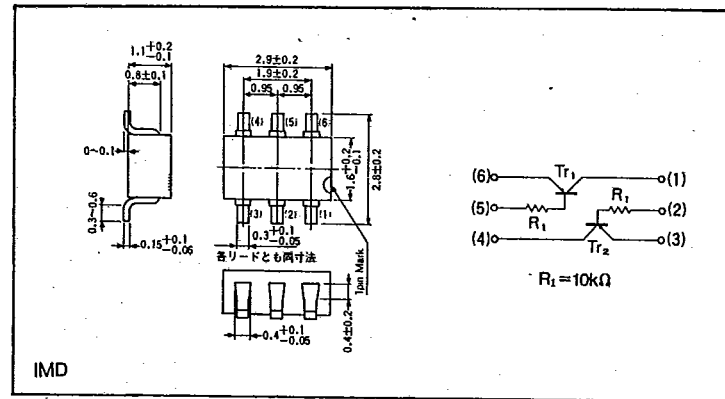
● 特長

- 1) SMT (SC-59) と同一体積に 2 個のトランジスタが入っている。
- 2) SMT の自動装着機により、装着が可能である。
- 3) 2 個のトランジスタの特性がそろっている。
- 4) 各トランジスタの素子間は独立しているため相互干渉がない。

● Features

- 1) Two transistors are housed in the same volume as SMT (SC-59).
- 2) The automatic mounting machine of SMT can be used for mounting.
- 3) The characteristics of 2 transistors are uniform.
- 4) No mutual interference exists between each transistor.

● 外形寸法図/Dimensions (Unit : mm)



トランジスタ

IMDタイプ

以下の特性は Tr_1 , Tr_2 について共通です。/ The following characteristics are common for Tr_1 , Tr_2 .

● 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings ($T_a=25^\circ\text{C}$)

Parameter	Symbol	Limits	Unit
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	-50	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	-50	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	-5	V
コレクタ電流	I_C	-100	mA
コレクタ損失	P_C	300 (TOTAL)*	mW
接合部温度	T_J	125	$^\circ\text{C}$
保存温度範囲	T_{stg}	-55~125	$^\circ\text{C}$

* ただし、1 素子当り 200mW をこえないこと。/ However, 200mW should not be exceeded per element.

● 電気的特性/Electrical Characteristics ($T_a=25^\circ\text{C}$)

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
コレクタ・エミッタ降伏電圧	BV_{CEO}	-50	—	—	V	$I_C=-1\text{mA}$
コレクタ・ベース降伏電圧	BV_{CBO}	-50	—	—	V	$I_C=-50\mu\text{A}$
エミッタ・ベース降伏電圧	BV_{EBO}	-5	—	—	V	$I_E=-50\mu\text{A}$
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	—	—	-0.5	μA	$V_{CB}=-30\text{V}$
エミッタシャ断電流	I_{EBO}	—	—	-0.5	μA	$V_{EB}=-4\text{V}$
直流電流増幅率	h_{FE}	100	250	600	—	$V_{CE}/I_C=-5\text{V}/-1\text{mA}$
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	—	—	-0.3	V	$I_C/I_E=-10\text{mA}/-1\text{mA}$
入力抵抗	R_1	—	10	—	k Ω	—

T-43-90

● 標準品・標準品一覧表

(○: 標準品)

Type	包装名	テーピング
	記号	T110
	基本発注単位(個)	3 000
IMB4		○

● 電気的特性曲線/Electrical Characteristic Curves

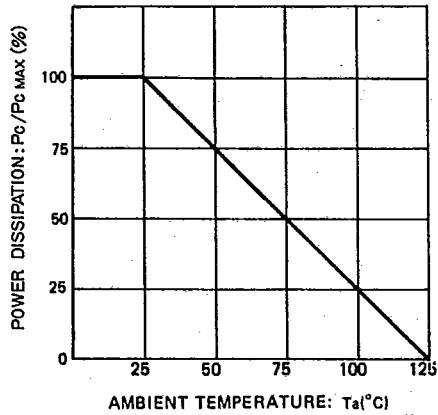


Fig.1 電力軽減曲線

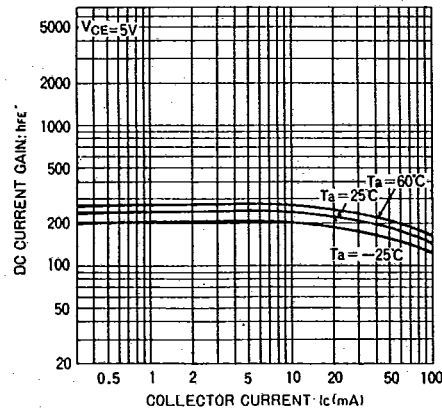
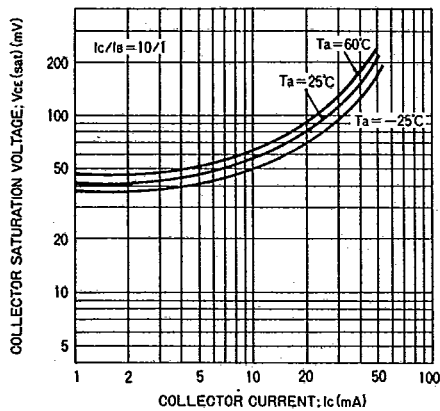


Fig.2 直流電流増幅率—コレクタ電流特性

Fig.3 コレクタ・エミッタ飽和電圧
—コレクタ電流特性